

엘피다, D램 개발경쟁 “삼성추월”

25나노 D램 개발 7월 상업생산 ... 기술개발체제 수정 결과 가시화

일본 엘피다(Elpida Memory)가 25나노 D램을 개발하면서 삼성전자를 추월해 화제가 되고 있다.

니혼게이지이신문에 따르면, 일본 반도체 생산기업인 엘피다는 회로 폭을 25나노미터(10억분의 1m)로 줄인 D램을 개발하는데 성공해 7월부터 Hiroshima 서부지역에 위치한 공장에서 생산에 나설 계획이다.

지금까지 초미세 반도체칩 개발 경쟁에서는 삼성전자가 앞서왔지만, 엘피다가 25나노 D램을 개발함으로써 판도를 뒤집은 것으로 평가되고 있다.

25나노 D램은 기억용량이 2기가바이트(20억바이트)로 컴퓨터나 스마트폰용으로 사용할 수 있으며, 30나노 D램보다 작기 때문에 반도체 원판(웨이퍼)당 반도체 칩 생산량이 늘어나 생산효율이 약 30% 향상될 것으로 예상되고 있다.

엘피다는 2011년 중으로 4기가바이트 D램도 생산할 것으로 알려지고 있다.

D램은 최첨단제품으로 1년에 수%씩 가격이 내려가기 때문에 개발 속도가 투자비 회수 여부로 직결되는 것으로 평가된다.

니혼게이지이신문은 “엘피다가 30나노 D램 개발에선 삼성전자에 약 6개월 뒤졌지만 1년 전부터 기술개발 체제를 수정한 끝에 20나노 D램 개발에 앞설 수 있었다”고 분석했다. <저작권자 연합뉴스 - 무단전재·재배포 금지>

<화학저널 2011/05/03>